

Silicon Diode

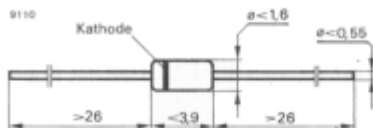
BAY69

50V / 150mA

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1988

BAY 68 · BAY 69**Silizium-Epitaxial-Planar-Dioden****Anwendungen:** Sehr schnelle Schalter**Abmessungen in mm**

Standard Glasgehäuse
54 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht max. 0,15 g

Bestempfung: Klartext**Absolute Grenzdaten**

Periodische Sperrsperrspannung

BAY 68	U_{RRM}	35	V
BAY 69	U_{RRM}	60	V

Sperrspannung

BAY 68	U_R	25	V
BAY 69	U_R	50	V

Stoßdurchlaßstrom

 $t_p = 1 \mu s$

I_{FSM}	2	A
-----------	---	---

Periodischer Durchlaßspitzenstrom

I_{FRM}	225	mA
-----------	-----	----

Durchlaßstrom

I_F	150	mA
-------	-----	----

Durchlaßstrom, Mittelwert

 $U_R = 0$

I_{FAV}	150	mA
-----------	-----	----

Verlustleistung

 $l = 4 \text{ mm}, T_L = 45 \text{ }^\circ\text{C}$

P_V	440	mW
-------	-----	----

 $T_L \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$

P_V	500	mW
-------	-----	----

Sperrschichttemperatur

T_j	200	$^\circ\text{C}$
-------	-----	------------------

Lagerungstemperaturbereich

T_{stg}	- 65 ... + 200	$^\circ\text{C}$
-----------	----------------	------------------

Maximaler Wärmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung

 $l = 4 \text{ mm}, T_L = \text{konstant}$

R_{thJA}	350	K/W
------------	-----	-----

BAY 68 · BAY 69

Kenngrößen		Min.	Typ.	Max.
$T_j = 25\text{ °C}$, falls nicht anders angegeben				
Durchlaßspannung				
$I_F = 100\text{ mA}$	U_F			1 V
Sperrstrom				
$U_R = 25\text{ V}$ BAY 68	I_R			100 nA
$U_R = 50\text{ V}$ BAY 69	I_R			100 nA
$T_j = 150\text{ °C}$				
$U_R = 30\text{ V}$ BAY 68	I_R			100 μA
$U_R = 50\text{ V}$ BAY 69	I_R			100 μA
Durchbruchspannung				
$I_R = 100\text{ }\mu\text{A}$	BAY 68	$U_{(BR)}^{1)}$	35	V
	BAY 69	$U_{(BR)}^{1)}$	60	V
Diodenkapazität				
$U_R = 0$, $f = 1\text{ MHz}$, $U_{HF} = 50\text{ mV}$	C_D			5 pF
Rückwärtserholzeit				
$I_F = I_R = 10\text{ mA}$, $i_R = 1\text{ mA}$, $R_L = 100\text{ }\Omega$	t_{rr}			10 ns

¹⁾ $\frac{t_p}{T} = 0.01$, $t_p = 0.3\text{ ms}$

BAY 68 · BAY 69

